

## 応用電子物性分科会研究例会

協賛：大阪大学グローバルCOEプログラム「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」

# GaN系電子デバイスの新展開

GaN系電子デバイスはその優れた物性から、既存デバイスの限界を超える性能・新機能が期待され、既に基地局向け高周波高出力デバイスとして商品化が始まり、電力用パワーデバイスとしての可能性も期待されております。本研究会においては、GaN電子デバイスの高性能化・高機能化に向けて導入が期待される新しいプロセス技術や構造について、最新の研究を御紹介いただくと共に、将来展望を議論することを目的としています。

<http://annex.jsap.or.jp/support/division/ohden/>

開催日時： 2007年12月5日（水）13：00～17：05

場所： 大阪大学吹田キャンパス 銀杏会館3階 阪急電鉄・三和銀行ホール  
(電話はありません)

(地図：<http://www.ichou.or.jp/access/access.html> \* 学外者用駐車場はありません)

### 演題：

(1) GaNの表面制御と電子デバイス応用

13:05～13:50 橋詰 保 (北海道大学)

(2) イオン注入を用いたGaNトランジスタ

13:50～14:35 中村 徹 (法政大学)

(3) ノーマリオフ型無極性a面AlGaIn/GaN  
ヘテロ接合トランジスタ

14:35～15:20 黒田正行, 上田哲三, 田中 毅 (松下電器産業)

— 休憩 (15分) —

(4) GaN縦型パワーデバイスの開発

15:35～16:20 加地 徹, 兼近将一, 上杉 勉 (豊田中央研究所)

(5) 窒化物半導体HBT

16:20～17:05 西川 敦, 熊倉一英, 牧本俊樹

(N T T物性科学基礎研究所)

参加費：当日受付 (テキスト代・消費税込) (事前受付はありません)

分科会会員：無料, 応物会員 (非分科会会員)：3,000円, 一般：4,000円, 学生：1,000円

問合せ先：津田邦男 (東芝)

E-mail: kunio.tsuda@toshiba.co.jp

近藤正彦 (阪大)

E-mail: kondow@ele.eng.osaka-u.ac.jp

原 直紀 (富士通研)

E-mail: hara.naoki@jp.fujitsu.com

佐野芳明 (沖電気)

E-mail: sano567@oki.com

小出康夫 (物材機構)

E-mail: koide.yasuo@nims.go.jp